Vol. 9, No.2, 2021-2022 (Serial No. 23)

Numerical Modeling of a Compact and High Contrast Reversible All Optical Feynman Gate with Nonlinear Kerr Effects Based on Two Dimensional Photonic Crystals

A. Farmani^{*1}, R. Beyranvand²

* Associate Professor of Sharif University, Tehran, Iran (Received: 30/08/2020; Accepted: 15/06/2021)

Abstract

In this study, we propose a Feynman gate based on two-dimensional photonic crystals taking into account the non-linear Kerr effects. These devices can operate at high speed, with low power consumption. The performance of the Feynman logic gate presented in this paper is based on the nonlinear effects of Kerr and the formation of identical waveguides to alternate the structure. The wavelength of this design is set in the range of 1550 nm. One of the advantages of this design is its small size of $7.54 \times 8.55 \ \mu m^2$ which has been achieved due to the use of three waveguides. The minimum optical power for the case of logic 1 is 0.95 and for case of logic 0 is 0.2. So, the contrast ratio of 8.4 dB can be obtained. Hence, the Feynman optical gate provided in this article is a good option for photonic computing circuits.

Keywords: Feynman Gate, Photonic Crystals, Non-Linear Kerr Effects

^{*} Corresponding author E-mail: farmani.a@lu.ac.ir

. نشربه علمی «اکترومغناطیس کاربردی » سال نهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰؛ ص ۱۵ – ۹

^{علمی -پ}ژو^{هشی} مدلسازی عددی گیت منطقی برگشتپذیر فاینمن تمام نوری بر مبنای اثرات غیرخطی کِر در بلورهای فوتونی دوبعدی با ابعاد بسیار کم و کنتراست بالا

على فرمانى 🛸، رضا بيرانوند

۱– استادیار، ۲– دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان (دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۹، پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵)

چکیدہ

هدف از این طرح، پیشنهاد یک گیت منطقی فاینمن مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی کر مییاشد. این افزارهها امکان طراحی پردازشگرهای با مصرف توان کم و سرعت بالا را فراهم میکنند. گیت منطقی پیشنهادی با در نظر گرفتن دو پارامتر شامل اثرات غیرخطی کر و ایجاد موجبرهای همسان برای تناوب ساختار، طراحی شده است. طولموج کاری گیت منطقی پیشنهادی در محدوده ۱۵۵۰ نانومتر تنظیم شده است. دستیابی به ابعاد کوچک یکی از نکات مهم در طراحی گیتهای منطقی منطقی نوری میاشد. در این رابطه، یکی از مزیتهای ساختار پیشنهادی اندازه کوچک آن ۲۹۵ مینه توان نوری دریافت شده به توان ورودی در حالت یک منطقی برابر با زمان تأخیر گیت منطقی برابر با ps ۲/۰ بهدست آمده است. نسبت کمینه توان نوری دریافت شده به توان ورودی در حالت یک منطقی برابر با ۸۹۹۰ و نسبت بیشینه توان نوری به توان ورودی در حالت صفر منطقی ۲/۰ است. در نتیجه میزان نسبت تباین گیت منطقی طراحیشده برابر Ad

كليد واژهها: گيت منطقي فاينمن، بلورهاي فوتوني، اثرات غيرخطي كر

۱. مقدمه

بـهصورت متـداول، مـدارهای دیجیتـالی کـه در سـامانههای الکترونیکی مورد استفاده قرار مـیگیرنـد از گیـتهای منطقی برگشتناپذیر ساخته شدهاند. به این معنی که در ایـن مـدارات از روی خروجی گیت منطقی، نمیتوان ورودی آن را بهطور منحصر به فرد تعیین کرد. از دستاوردهای محاسبات کوانتـومی، طراحـی گیـتهای منطقـی برگشـتپـذیر اسـت. هـر گیـت منطقـی برگشت پذیر، یک واحد منطقی K ورودی و K خروجی است کـه روی هر بردار خروجی منحصر به فرد رسید و بـرعکس از روی هر بردار خروجی می منحصر به عبارت دیگـر یک تناظر بهصورت منحصر به فرد تعیین کرد. به عبارت دیگـر یک تناظر یک به یک بین ورودیها و خروجیهای گیت برگشت پذیر برقرار است. ویژگی گیتهای برگشت پذیر : ۱ - خروجی بلا استفاده یک گیت برگشت پذیر بهعنوان خروجی ناخواسته شـناخته مـیشـود. ۲- در منطق برگشت پذیر، تعداد خروجی هر گیت محـدود شـده

است و از هر خروجی فقط یکبار میتوان استفاده کرد.۳- تـ أخیر یک مدار برگشت پذیر، بیشترین تعداد گیتها در یک مسیر از هر خط ورودی به هر خط خروجی است. در سال های اخیر، کریستال های فوتونی بهدلیل سادگی و امکان کنترل سیگنال ورودی در طراحی گیتهای منطقی مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند. در این ساختارها برای هدایت نور در مسیرهای مشخص از موجبرهای فوتونی استفاده می شود [۱]. اولین گام برای توسعه محاسبات بر اساس فوتون، طراحی و ایجاد دروازههای منطقی تمام نوری است. در همین زمینه، گیتهای منطقی OR ، AND، XOR، NOT و NAND مبتنی بر کریستالهای فوتونی دو بعدی با استفاده از موجبر و رینگ رزناتور توسط گروههای تحقیقاتی پیشنهاد و بررسی شدهاند [۲- ۵]. ساختارهای مبتنی بر موجبرهای فوتونی به محققان امکان طراحی افزارههایی با مقیاس کوچک را میدهند. چنین ساختارهایی امکان یکپارچـهسازی در مدارهای نوری را فراهم میسازند. در تحلیل بلورهای فوتونی، از روش بسط امواج تخت (PWE) برای محاسبه ساختار نواری استفاده می شود [۶–۹]. در این روش با درنظر گرفتن شرایط اولیه

^{*} نویسنده پاسخگو: farmani.a@lu.ac.ir

و مرزی معلوم، تحلیلها صورت میگیرد.

اولین ساختار پیشنهادی در مورد گیت فاینمن مربوط به L.E. Pedraza Caballero و همکاران بود [۸]. ساختار پیشنهادی میلههای سیلیکونی بر بستر هوا است. نوع چینش میلههای دیالکتریک را مثلثی، ثابت شبکه مورد نظر برای تمام میلهها ۸۷۵ نانومتر و شعاع تمام میلهها ۴۹۵ نانومتر در نظر گرفته شده است. ورودی A را ابتدا بهصورت یک تقسیمکننده توان ایجاد کردند سپس ورودی B را در کنار یکی از شاخههای این تقسیمکنندهها ایجاد کردند. ابعاد طرح پیشنهادی آنها ۱۱۳۴,۶۵ µm²

کارهای ارزشمند گروههای تحقیقاتی قبل دارای مزایای بسیار خوبی هست اما اخیراً ساختارهای گیتهای منطقی برگشتپذیر از نظر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. بنابراین در این مقاله یک گیت منطقی برگشتپذیر با ابعاد کوچک و همچنین نرخ کنتراست بالا مبتنی بر بلور فوتونی پیشنهاد میشود.

در ایسن مقاله، یک گیت منطقی تمام نوری فاینمن برگشت پذیر را بر اساس ساختار سیلیکونی پیشنهاد شده است. این افزاره با استفاده از موجبر فوتونی و همین طور چند موجبر طراحی شده است. در این طرح از اثر تداخل کر نیز استفاده شده است. برای مطالعه رفتار ساختار پیشنهادی از روش FDTD استفاده شده است.

۲. گیت منطقی فاینمن پیشنهادی

درگاه دو کیوبیتی گیت منطقی فاینمن یا NOT – controlled از جمله مهمترین درگاههای کنترلی و برگشت پذیر به شمار می رود. درگاههای کنترلی بر روی دو یا تعداد بیشتری کیوبیت اثر می کنند. در این درگاهها کیوبیتهای کنترل و هدف داریم. یک یا تعداد بیشتری کیوبیت می توانند کیوبیت کنترل باشند و با توجه به مقدار آنها، اعمالی روی کیوبیتهای هدف انجام می شود. در کیوبیت فاینمن یک کیوبیت کنترل و یک کیوبیت هدف داریم. این گیت دارای دو ورودی A و B و دو خروجی P و Q است [۸]. بیت ورودی A در حقیقت بیت کنترلی است. از آنجا که مل کپی کردن در منطق برگشت پذیر مجاز نیست می توان از گیت فاینمن برای تولید دوباره ورودی استفاده کرد. شکل (۱) بلوک دیاگرام گیت فاینمن را نشان می دهد. جدول (۱) جدول



شکل (۱): بلوک دیاگرام گیت منطقی فاینمن

جدول (۱): جدول صحت گیت منطقی فاینمن

Input		Output		
А	В	Р	Q	
0	0	0	0	
0	1	0	1	
1	0	1	1	
1	1	1	0	

۳. ساختار پیشنهادی

در این قسمت ابتدا ساختار پیشنهادی معرفی می گردد. شکل (۲) ساختار اصلی طرح پیشنهادی را نشان میدهد. در این شبیهسازی از میلههای سیلیکونی بر بستر هوا استفاده شده است. مقادیر ضریب شکست سیلیکون و هوا به ترتیب ۳/۴۶ و ۱ است. نوع چینش طرح پیشنهادی به صورت مثلثی و همین طور ابعاد کلی طرح ^۲ ۷٫۵۴ «۸٫۵۵μm است. ثابت شـبکه (a) در ابتـدا روی ۱۰۰۰ نانومتر تنظیم شده بود که طبق اصل مقیاس پذیری برای اینکه طول موج کاری روی ۱۵۵۰ نانومتر تنظیم شود ثابت شبکه به ۵۰۳ نانومتر تغییر دادهشده است. شعاع میلههای سیلیکونی (R)۱۳۵ نانومتر است. ساختار دارای دو ورودی A و B و دو خروجی P و Q است. از یک نقص غیرخطی که با N2 نشان دادهشده است و نوع ماده برای این نقص را چلکوجناید با ضریب شکست ۳/۱ و ضریب شکست غیرخطے ²⁰ و با شعاع ۹۹ نانومتر در نظر گرفته شده است. مواد چلکوجناید ترکیبات آمورف متشكل از سولفيدها، سلنيدها، تلوريدها هستند كه با آرسنايد و ژرمانیوم ترکیب می شوند. خاصیت غیر خطی این مواد بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر سیلیکا می باشد. بنابراین در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.



ساختار باند، اصلی ترین و مهم ترین مشخصه یک بلور فوتونی است که در بلورهای فوتونی از نوع دیالکتریکهای معمولی، پس از ساخت، ثابت بوده و قابل تغییر نیست. نرمافزار مورد استفاده نسخه تجاری Rsoft است. ساختار باند برای حالت TM در شکل (۳) بهدست آمده است. ساختار باند محاسبه شده نشان می دهد که فاصله باند ممنوعه از ۲۹۶۴ > $\frac{\mu}{k}$ > ۲۹۶/۰ واقع شده است. سپس منابع طول موج انتخابی باید در محدوده PBG باشند بنابراین، طول موج ۱۵۵۰ نانومتر برای این شبیه سازی انتخاب شده است.



شکل (۳): شکاف باند فوتونی طرح پیشنهادی

۴. اثرات غيرخطي

ضریب شکست بسیاری از مواد نوری وابسته به شدت میدانی است که درون آن ماده منتشر می شود. این ویژگی از خواص مهم مواد غیرخطی است که منشأ کاربردهای بسیاری میباشد. هرگاه شدت نوری که در محیطی انتشار مییابد بالا باشد آنگاه ضریب شکست به خاطر اعمال مرتبه سوم پذیرفتاری در قطبیدگی تغییر میکند. چنین تغییری در ضریب شکست باعث ایجاد اثرهای اپتیکی غیرخطی نظیر خود کانونی برای پرتوهای گوسی میباشد. این اثر تنها در نور با شدت بالا روی میدهد و تغییری که در ضریب شکست ایجاد می شود متناسب با شدت مکانی نور است [۹– ۱۱]. این پدیده به اثر کر مشهور است. در این مواد رابطه ضریب شکست به صورت زیر می باشد:

$$n(I) = n_0 + n_1 * I \tag{1}$$

ما برای این کار نیاز به مقدار پذیرفتاری ۳ داریم. برای این منظور

ما از رابطهای که در کتاب رابرت بوید (۱۲) بود استفاده کردیم :

$$x^3 = \frac{N_2 N_0^2 C}{12\pi^2} \tag{(7)}$$

در این رابطه که بهعنوان پذیرفتاری ویژه غیرخطی شـناخته میشود مقدار N₂ ضریب شکست غیرخطی ماده مورد نظر است و N₀ مقدار ضریب شکست خطی مـاده مـورد نظـر و همچنـین C مقدار سرعت نور در خلأ است.

۵. روش محاسبات شبیهسازی

تفاضل محدود در حوزه زمان که بهصورت خلاصه با نام FDTD شناخته میشود، یکی از پیشرفته ترین روش های عددی است که در این کار از آن استفاده شده است. روش تفاضل محدود که برای محاسبه توزیع میدان داخل ساختار اپتیکی با ضریب شکست غیریکنواخت به کار می رود، اولین بار توسط یی در سال ۱۹۶۶ ارائه گشت. در این روش فضای پیوسته با مجموعه پیوسته از گرهها جایگزین می شود. مشتقات جزئی در معادلات ماکسول به وسیله تفاضل های محدود جایگزین می شود که یک سیستم از و معادلات جبری که نسبت به مختصات خطی است ایجاد می شود مرزی حل می شود. در هر حال به علت گسسته سازی فضا، و معادلات ماکسول مرحله به مرحله و با شروع از شرایط اولیه مزی حل می شود. در هر حال به علت گسسته سازی فضا، و معادلات ماکسول مرحله به مرحله و با شروع از شرایط اولیه مرزی حل می شود. در هر حال به علت گسسته سازی فضا، و معادلات ماکسول مرحله به مرحله و با شروع از شرایط اولیه مرزی حل می شود. در هر حال به علت گسسته سازی فضا، و معادلات ماکسول مرحله به مرحله و با شروع از شرایط اولیه مرزی حل می شود. در هم حال به علت گسسته سازی فضا، و معادلات ماکسول مرزهای نامحدود بایستی از شرایط مرزی جذبی دارد. برای شره مازهای خارجی شبکه استفاده کرد. در یک PML ایده آل هیچ موج بازتابیده ای باقی نمی ماند [۱۳].

۶. نتایج

در این بخش با در نظر گرفتن نکات بخش قبل، ارزیابی ساختار را انجام می دهیم. بعد از اتمام مراحل طراحی، شبیه سازی را با PDTD میدان نوری ورودی به ساختار انجام دادیم. روش FDTD برای محاسبه توزیع میدان در افزاره های مبتنی بر بلور فوتونی است. این روش مبتنی بر گسسته سازی فضا و مکان به صورت یک در میان است [۱۴]. با این روش حل، میتوان تمام ساختارهای پیچیده و نامتناوب را شبیه سازی کرد. همچنین می توان از آن برای محاسبه مدهای ویژه و به دست آوردن دیاگرام باند، نیز استفاده کرد. در این پژوهش از ابزار FullWAVE، برای به رای به را بردن از روش DTD، استفاده شده است. با درنظر گرفتن تمام حالات گیت منطقی فایمن، توزیع میدان و نمودارهای انتقالی به دست آمده است. شکل (۴) توزیع میدان الکتریکی در شرایط 1.0





شکل (۴): توزیع میدان الکتریکی برای حالت A (۰) ، B (۱)





شکل (۵): طیف خروجی برحسب طول موج برای حالت A (۰) ، B (۱)

در شکل (۶)، حالت دوم منطبق بر جدول (۱) مورد بررسی قرار گرفته است و پروفایل میدان الکتریکی محاسبه شده است. همچنین برای این حالت نمودار انتقال توان در شکل (۷) بهدست آمده است.

در نهایت جهت بررسی حالت منطقی ۱۱، با درنظر گرفتن پارامترهای اولیه ساختار و اعمال نور ورودی به هر دو پورت ورودی، میزان پروفایل منتشره مورد محاسبه قرار گرفته است. در شکل (۸) نتیجه این حالت فراهم شده است.



شكل (۷): طيف خروجى برحسب طول موج براى حالت A(۱) ، B(۰)



جهت محاسبه میزان توان انتقالی نمودار توان مبتنی بر طول موج محاسبه شده است. همان طور که در شکل (۹) دیده می شود، در حالت ۱۱، بیشینه توان انتقالی در حالت یک منطقی در حدود ۰٫۹۵ بهدست آمده است. و همچنین در حالت صفر منطقی در حدود ۲/۲ خواهد بود که نشان دهنده میزان نرخ تباین بالا خواهد بود.



شکل (۹): طیف خروجی برحسب طول موج برای حالت (A(۱)، B(۱))

۷. نتایج پاسخ زمانی

مطالعه روی پاسخ زمانی و سرعت ابزار یکی از معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی رفتار وسیله نوری است. طول موج کاری، شعاع میلههای دیالکتریک، شعاع نقصها و همین طور ضریب شکست به طور مستقیم بر نرخ تباین تأثیر گذار است [۱۵]. نتایج شبیه سازی برای حالتهای خیزش و افت گیت فاینمن نوری در شکلهای (۱۰–۱۲) نشان داده شده است. عملکرد گیت را می توان با محاسبه نسبت تباین (CR)، که نسبت بین قدرت خروجی منطق "۱" و منطق "۰" که به عنوان عملکرد می باشد، مورد مطالعه قرار داد.

CR = 10 log (P1/P0) (۳) همان طور که در نمودار شکلهای (۱۰–۱۲) مشاهده می شود، میزان تأخیر در حالتهای مختلف در محدوده پیکوثانیه و کمتر از ۱ پیکوثانیه می باشند. بنابراین انتظار داریم، مدل پیشنهادی برای سرعتهای بالا مورد استفاده قرار گیرد.



شکل(۱۰): خروجی بر حسب زمان برای حالت (A (۰) ، B (۱))



شکل (۱۱): خروجی بر حسب زمان برای حالتهای (A (۱)، B (۰))



شکل (۱۲): خروجی بر حسب زمان برای (A (۱)، B (۱))

طبق سه نمودار زمانی برای سه حالت ورودی، مقدار CR و همینطور زمانهای خیزش و افت را در جدول (۲) بهدست آمده است.

جدول (۲): جدول زمانی خیزش و افت و همین طور نسبت تباین طرح پیشنهادی

Inj	put	Output			Time [Ps]	
А	В	P%	Q%	CR (dB)	tr	Tf
0	0	0≡"0"	$0 \equiv ``0"$	-	-	-
0	1	14="0"	73≡"1"	7.23	0.4	0.2
1	0	92="1"	71="1"	1.12	0.2	0.1
1	1	97≡ ''1''	4≡"0"	8.4	0.35	0.1

۸. مقایسه با طرحهای مشابه

در این قسمت نتایج بهدستآمده از طرح را با سایر پژوهشهای پیشین مقایسه کرده و در جدول (۳) آورده شده است.

جدول (۳): جدول مقایسه طرح پیشنهادی با سایر پژوهشها

		Non- Output Powe		Power	
REF.	CR(dB)	Dimension	linear	high(1)	low(0)
[18]	۶	וודי/۶۵ μm^2	No	۴۰	۱۰
[\Y]	۵	•/۶۳&τ٣/λ mm ²	No	٨٠	٨
[\\]	۶	۱۲*۱· <i>µ</i> m ²	No	٩٠	٢٢
[19]	۷	$11 \Delta \mu m^2$	Yes	٩٨	18
[7.]	٨	$1 \cdot \cdot \mu m^2$	Yes	٩۵	١٢
[71]	۲۰	۱۳ * ۱۰ <i>µ</i> m ²	Yes	۵۲	•/•۵
[77]	۱.	μm^2	No	٨٠	۵
[٢٣]	٨	λ/λΔ μm^2	Yes	٨۵	۲.
This Work	٨/۴	$\lambda/\Delta\Delta * V/\Delta^{4}$ μm^{2}	Yes	٩۵	۲۰

۹. نتیجهگیری

در این طرح، یک گیت منطقی فایمن برگشت پذیر با ابعاد کوچک در محدوده طول موج مخابراتی پیشنهاد شد. ساختار پیشنهادی دارا ابعاد 2 μm² ۸٫۵۵×۷٫۹۴ است جهت ارزیابی مدل پیشنهادی پارامترهای پاسخ زمانی و همچنین نرخ تباین مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که زمان تأخیر گیت منطقی برابر با ۲۶ ۲/۰ است. نسبت کمینه توان نوری دریافت شده به توان ورودی در حالت یک منطقی برابر با ۹۵/۰ نسبت بیشینه توان نوری به توان ورودی در حالت صفر منطقی نسبت بیشینه توان نوری به توان ورودی در حالت صفر منطقی اسبت بیشینه توان نوری به توان ورودی در حالت صفر منطقی نسبت منطقی طراحی شده برابر طB ۸/۴ به دست آمده است. همان طور که نتایج حل عددی نشان دادند، ساختار پیشنهادی می تواند جهت کاربردهای با

۱۰. مراجع

- A. Mohebzadeh Bahabadi and S. Olyaei, "Design of an All-Optical AND Logic Gate based on Photonic Crystal with Small Dimensions Suitable for Integrated Optical Circuits," Journal of Applied Electromamnetic, vol. 1, pp. 53-59, 2018. (In Persian)
- [2] R. Cavin, P. Lugli, and Y. Zhirnov, "Science and engineering beyond Moore's law," Proceedings of the IEEE, vol. 100, no. Special Centennial Issue, pp. 1720-1749, May 2012.
- [3] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, N. Winn, and R. D. Meade, "Photonic Crystals: Molding the Flow of Light," P. U. Press, Ed. Princeton University Press, 2008.
- [4] A. Piccardi, A. Alberucci, U. Bortolozzo, S. Residori, and G. Assanto, "Soliton gating and switching in liquid crystal light valve," Applied Physics Letters, vol. 96, no. 7, p. 071104, 2010.
- [5] J. F. Tao, J. Wu, H. Cai, Q. X. Zhang, J. M. Tsai, J. T. Lin, and A. Q. Liu, "A nanomachined optical logic gate driven by gradient optical force," Applied Physics Letters, vol. 100, no. 11, 2012.
- [6] H. Soto, E. Diaz, J. Topomondzo, D. Erasme, L. Schares, and G. Guekos, "All-optical AND gate implementation using crosspolarization modulation in a semiconductor optical amplifier," Photonics Technology Letters, IEEE, vol. 14, no. 4, pp. 498-500, April 2002.
- [7] S. G. Johnson and J. D. Joannopoulos, "Block-iterative frequency-domain methods for Maxwell's equations in a planewave basis," Opt. Express, vol. 8(3), pp. 173–190, 2001.
- [8] L. E. Pedraza Caballero, J. P. Vasco, P. S. S. Guimadies, and O. P. Vilela Neto, "AII-Optical Majority and Feynman Gates in Photonic Crystals," IEEE 978-1-4673-7162-9/15, 2015.
- [9] P. Kumar Biswas, A. Newaz Bahar, M. D. Ahsan Habib, and M. D. Abdullah-Al-Shafi, "Efficient Design of Feynman and Toffoli Gate in Quantum dot Cellular Automata (QCA) with Energy Dissipation Analysis," Nanoscience and Nanotechnology, vol. 7(2), pp. 27-33, 2017.
- [10] Berenger, Jean-Pierre, "A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves," Journal of computational physics, vol. 114.2, pp. 185-200, 1994.

- [18] M. M. Karkhanehchi, F. Parandin, and A. Zahedi, "Design of an all optical half-adder based on 2D photonic crystals," Photonic Network Communications, vol. 33.2, pp. 159-165, 2017.
- [19] M. J. Maleki, A. Mir, and M. Soroosh, "Ultra-fast alloptical full-adder based on nonlinear photonic crystal resonant cavities," Photonic Network Communications, pp. 1-9, 2020.
- [20] M. Danaie and H. Kaatuzian, "Design and simulation of an all-optical photonic crystal AND gate using nonlinear Kerr effect," Optical and Quantum Electronics, vol. 44.1, pp. 27-34, 2012.
- [21] Z. Mohebbi, N. Nozhat, and F. Emami, "High contrast all-optical logic gates based on 2D nonlinear photonic crystal," Optics Communications, vol. 355, pp. 130-136, 2015.
- [22] T. Sadeghi, et al., "Improving the performance of nanostructure multifunctional graphene plasmonic logic gates utilizing coupled-mode theory," Applied Physics B, vol. 125.10, pp. 1-12, 2019.
- [23] A. Farmani, A. Mir, and M. Irannejad, "2D-FDTD simulation of ultra-compact multifunctional logic gates with nonlinear photonic crystal," JOSA B 36.4, pp. 811-818, 2019.

- [11] F. Bohren Craig and R. Donald Huffman, "Absorption and scattering of light by small particles," John Wiley & Sons, 2008.
- [12] R. W. Boyd, Nonlinear Optics 3rd edn, Academic, 2008.
- [13] A. Taflove and M. E., Brodwin, "Numerical Solution of Steady-State Electromagnetic Scattering Problems Using the Time-Dependent Maxwell's equations," IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques, pp. 623-630, 1975.
- [14] A. Igor and A. Sukhoivanov, "Photonic crystals: Physics and Practical Modeling," Springer Series in Optical Sciences, vol. 152, pp. 41-65, 2009.
- [15] Y. Kane, "Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell's equations in isotropic media," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 14, pp. 302-307, 1966.
- [16] R. Rajasekar, R. Latha, and S. Robinson, "Ultra-contrast ratio optical encoder using photonic crystal waveguide," 0167-577X, 2019.
- [17] R. Sattibabu and G. Pranabendu, "Design of reversible optical Feynman gate using directional couplers," Optical Engineering, vol. 59.2, p. 027104, 2020.